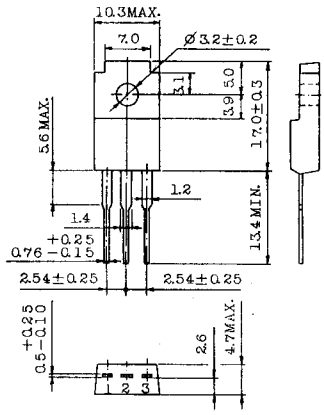
2SB1017

シリコンPNP三重拡散形

○ 電力増幅用

単位：mm

- h_{FE}の直線性が良い。
- 2SD1408とコンプリメンタリになります。
- 20~25Wハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。



1. ベース
2. コレクタ
3. エミッタ

JEDEC	—
EIAJ	—
東　芝	2-10L1A

最大定格 (Ta = 25°C)

項　　目	記　号	定　　格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−4	A
ベース電流	I_B	−0.4	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55~150	°C

電気的特性 (Ta = 25°C)

項　　目	記　号	測　定　条　件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB} = −80V, I_E = 0	—	—	−30	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB} = −5V, I_C = 0	—	—	−100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C = −50mA, I_B = 0	−80	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	V_{CE} = −5V, I_C = −0.5A	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	V_{CE} = −5V, I_C = −3A	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C = −3A, I_B = −0.3A	—	−1.0	−1.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	V_{CE} = −5V, I_C = −3A	—	−1.0	−1.5	V
トランジション周波数	f_T	V_{CE} = −5V, I_C = −0.5A	—	9	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB} = −10V, I_E = 0, f = 1MHz	—	130	—	pF

注：$h_{FE(1)}$分類　R：40~80,　O：70~140,　Y：120~240